

Tra i materiali a semiconduttori nanostrutturati saranno illustrate le proprietà di silicio, germanio, semiconduttori III-V quali fosforo d'indio, arseniuro di gallio, fosforo di gallio e relative leghe ternarie e quaternarie ottenute per epitassia a fascio molecolare per la realizzazione eterogiunzioni e pozzi quantici impiegati nelle realizzazioni di laser, LED, celle solari e fotorivelatori per ricevitori ottici.